高効率 InGaAs 光伝導層を用いた 1.5 μm 帯励起用光伝導アンテナのサブテラヘルツ波発生・検出特性

Sub-Terahertz Wave Emission and Detection Properties of Photoconductive Antennas based on Highly Efficient InGaAs Photoconductive Layers for 1.5 μm Excitation

パイオニア(株) 加茂 喜彦, 伊田 孝寛, 栗田 暢之, 田中 亮太

Pioneer Corp. Yoshihiko Kamo, Takahiro Ida, Masayuki Kurita, Ryota Tanaka

E-mail: yoshihiko_kamo@post.pioneer.co.jp

1. はじめに

テラヘルツ時間領域分光法 (THz-TDS) による光励起方式の THz イメージングシステムを小型で安価に実現するためには、通信分野での開発が進み低コスト化している 1.5 μm 帯レーザー用の光学部品やデバイスの活用が有効である。そのためには、1.5 μm 帯励起用の光伝導アンテナ (PCA) が必要である[1]。

我々は以前、PCA の光伝導層においては、発生用は高いキャリア移動度が、検出用は短いキャリア寿命が重要であることを示した[2][3]。そして 1.5 μm 帯レーザー励起の発生用と検出用に最適化した 2 種類の In_{0.53}Ga_{0.47}As 光伝導層を用いた PCA において、周波数 0.5~2 THz で高効率な THz 波の発生・検出特性を示した[4]。

本研究では、THz イメージングの用途拡大のために、ゴム、木材等の、0.1~0.2 THz で透過率が高い材料への適用を考え、ダイポールアンテナの共振周波数を 0.1 THz に設計すると共に、同じアンテナ長のボウタイアンテナも設計し、0.5 THz 以下の低周波数での広帯域化[5]の効果について検証した。

2. 実験

分子線エピタキシー法 (MBE) を用いて発生用と検出用に 2 種類の高効率な In_{0.53}Ga_{0.47}As 光伝導層を各 InP 基板上に成長させた[3]。

Fig. 1 に発生用と検出用の 2 種類の光伝導層上に形成したアンテナの構造と寸法を示す。ダイポールアンテナ (DP) とボウタイアンテナ (BT) を各光伝導層上に形成し、PCA を作製した。

THz 波の発生・検出評価には、1.56 μm フェムト秒ファイバーレーザー (Menlo Systems 社製: パルス幅 70 fs 以下、繰り返し周波数 100 MHz) を励起光源とした THz-TDS を使用した。発生用 PCA には正弦波のバイアス電圧 (耐電圧の 6 割の電圧) を印加した。測定した THz 波時間波形をフーリエ変換し、スペクトル DR(ω)=10log₁₀(I(ω)/N(ω))を導出した。ここで、I(ω)は、検出した THz 波の強度、N(ω)は THz 波が発生していない時の検出ノイズである。

3. 結果

Fig. 2 に作製した PCA を THz 波の発生と検出に用いた時の各 THz スペクトルを示す。発生と検出にボウタイアンテナを使用した時に 0.2 THz 付近にピークを持ち DR が最大となった。検出にダイポールアンテナを使用すると 0.1 THz 付近がピークとなった。ボウタイアンテナによる広帯域化の効果は、検出側にボウタイアンテナを使用した時が顕著であった。

講演では上記データの詳細を示すと共にイメージングへの適用について報告する。

Fig. 1. Schematic structure of each antenna on each InGaAs layer optimized for emitter and detector.

Fig. 2. THz spectra obtained by emitter (E) and detector (D) with respective antennas.

参考文献

- [1] R.J.B. Dietz et al., Opt. Express **22** (16), 19411 (2014).
- [2] Y. Kamo et al., Jpn. J. Appl. Phys. **53**, 032201 (2014).
- [3] 加茂 他, 第 63 回応用物理学会春季学術講演会, 20p-H135-11 (2016).
- [4] 栗田 他, 第 63 回応用物理学会春季学術講演会, 20p-H135-12 (2016).
- [5] H. Harde et al., J. Opt. Soc. Am. **B 8**, 1642 (1991).